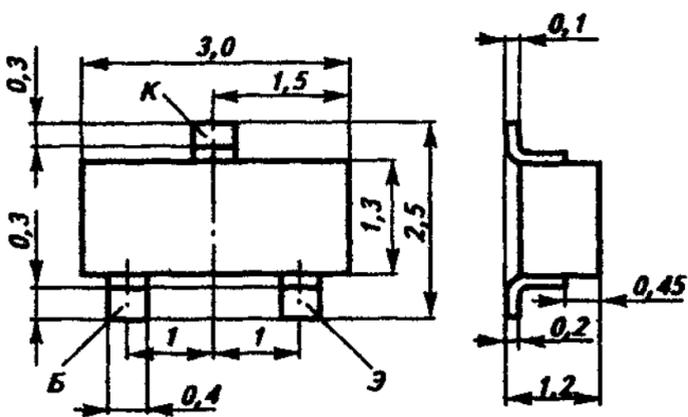
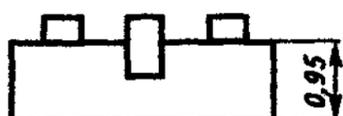


□ КТ216А, КТ216Б, КТ216В



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры $p-n-p$ универсальные. Предназначены для применения в усилителях, генераторах, в стабилизаторах напряжения и тока, импульсных устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Масса транзистора не более 0,1 г.



КТ216 (А-В)

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 5 В$, $I_э = 1 мА$:

КТ216А	9...50
КТ216Б	30...150
КТ216В	30...200

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 5 В$, $I_э = 1 мА$,

не менее 25 МГц

Граничное напряжение при $I_э = 10 мА$, не менее:

КТ216А	60 В
КТ216Б	30 В
КТ216В	15 В

Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 5 В$, не более 10 пФ

Обратный ток коллектора при $U_{кб} = U_{кб, макс}$ не более 1 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = U_{эб, макс}$ не более 1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:

КТ216А	60 В
КТ216Б	30 В
КТ216В	15 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{бэ} = 2 кОм$:

КТ216А	60 В
КТ216Б	30 В
КТ216В	15 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:

КТ216А	30 В
КТ216Б	15 В
КТ216В	10 В

Постоянный ток коллектора 10 мА

Импульсный ток коллектора при $t_{И} = 1 мкс$, $Q = 10$ 20 мА

Постоянная рассеиваемая мощность¹ коллектора:

$T = -60...+25^{\circ}C$ 75 мВт

$T = +85^{\circ}C$ 30 мВт

Импульсная рассеиваемая мощность¹ коллектора при $t_{И} = 1 мкс$, $Q = 10$:

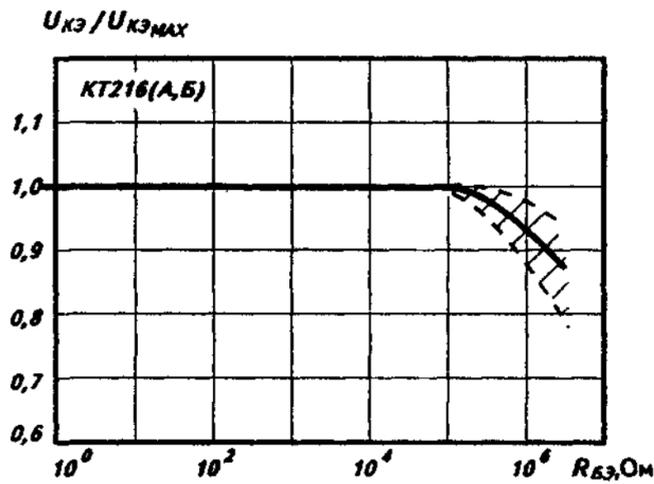
$T = -60...+25^{\circ}C$ 100 мВт

$T = +85^{\circ}C$ 75 мВт

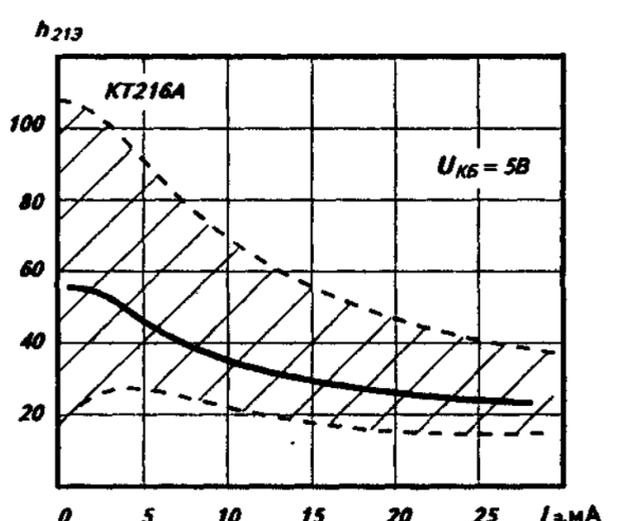
Температура $p-n$ перехода $+125^{\circ}C$

Температура окружающей среды $-60...+85^{\circ}C$

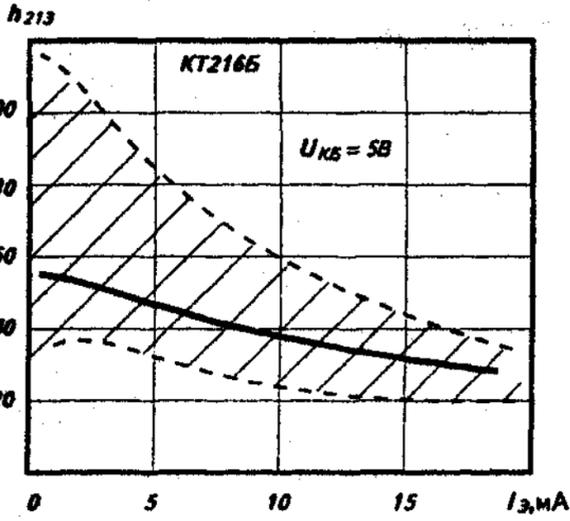
¹ При $T > +25^{\circ}C$ максимально допустимые постоянная и импульсная рассеиваемые мощности коллектора уменьшаются линейно.



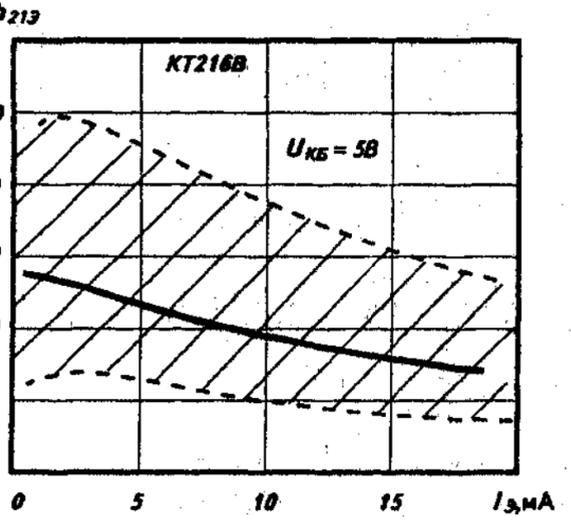
Зависимость напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления в цепи база-эмиттер КТ216(А-Б)



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера транзистора КТ216А



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера транзистора КТ216Б



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера транзистора КТ216В